

[illegible]

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
100k	0805-0.125 Вт -100 кОм±5%	R1	0805	0.125Вт 0805 100 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1
6.2k	0805-0.125 Вт -6.2 кОм±5%	R2, R3	0805	0.125Вт 0805 6.2 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	2
6.8K	0805-0.125 Вт -6.8 кОм±5%	R4	ST32	0.125Вт 0805 6.8 кОм, 5%, подстроечный чип резистор (SMD)	1
Полевой транзистор с изолированным затвором	IRFML8244TRPBF	VT1	SOT23	IRFML8244TRPBF	1
Биполярный транзистор n-p-n	BFR540	VT2, VT3	SOT23	BFR540, BFR540_1	2
Полевой транзистор с изолированным затвором n-типа	BSS83P H6327XTSA1	VT4	SOT23	BSS83P H6327XTSA1	1
SM02B	SM02B	XS1, XS2	CI1102M1H (F)	SM02B	2